交叉学科

不同LET ¹²C⁶⁺离子对生防菌BJ1的辐射诱变效应 马爽^{1,2}, 李文建^{1,#}, 王菊芳¹, 周利斌¹, 余丽霞¹, 董喜存^{1,2}, 陆栋^{1,2}, 刘敬¹ 1 中国科学院近代物理研究所, 甘肃 兰州 730000;

2 中国科学院研究生院, 北京 100049 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期 摘要

选取高低两个LET点(40和60 keV/??m),剂量点分别为50,100,200,400,600 Gy进行辐照处理,研究了 生防菌的存活率与突变率的关系, 抑菌谱以及活性等。 结果表明, 在高LET条件下, 低剂量辐照就可以得到较多的 突变体, 并且BJ1有较高的存活率和突变谱, 有利于筛选优良的正突变体。 因此高LET较低LET有更为明显的辐射 诱变效应。

To explore the effects of different linear energy transfer(LET) of ¹²C⁶⁺ ion Beam irradiation on ▶ 本刊中 包含"传能线密度"的 相 BJ1, survivals and biocontrol effects were cultured and treated with LET =40 and 60 keV/µm at the doses of 50, 100, 200, 400 and 600 Gy, respectively. The results showed more mutations and biocontrol charts and higher survivals were obtained with high LET(60 keV/µm) irradiations at lower dose, which was useful to screen good positive mutations. Based on the results above, it could be concluded that the condition of high LET(60 keV/µm) had obvious mutagenic effects than that of low LET(40 keV/µm).

关键词 传能线密度 C离子 生防菌BJ1 辐射 诱变效 分类号

DOI:

通讯作者:

李文建 mashuang006@impcas.ac.cn

作者个人主页:

马爽^{1; 2}; 李文建^{1; #}; 王菊芳¹; 周利斌¹; 余丽霞¹; 董喜存^{1; 2}; 陆栋^{1; 2}; 刘敬¹

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(791KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶ 参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- 加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert

相关信息

- 关文章
- ▶本文作者相关文章
- . 马爽
- · 李文建
- 王菊芳
- 周利斌
- 余丽霞
- 董喜存
- <u>陆栋</u>